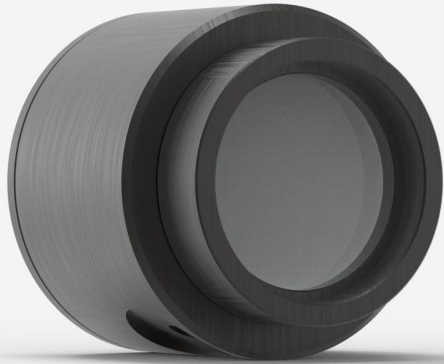




gentec-EO

PH20-GE-OD1-D0

光电二极管探测器的激光功率测量高达 300 mW。



产品系列主要特性

大光圈

硅传感器光圈为10 mm直径

3种型号

- 硅 350 - 1080 nm, 高达750 mW
- 紫外硅 210 - 1080 nm, 高达38 mW
- 锗 800 - 1650 nm, 高达500 mW

衰减器选择

- OD0.3: 50% 传输(PH100-Si^{UV})
- OD1: 10% 传输
- OD2: 1% 传输

高准确度

全新PH100-Si-HA大幅降低校准不确定因素

准确校准

波长选择 1 nm一格

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性支架

[STAND-D-233](#)

规格

测量能力

| | |
|-----------------------|---|
| 最大平均功率 ¹ | 300 mW |
| 噪声等效功率 ² | 600 pW |
| 光谱范围 | 900 - 1650 nm |
| 典型升起时间 | 0.2 s |
| 功率校准不确定性 ³ | ±5.0 % (900 - 1559 nm) ±7.0 % (1560 - 1629 nm) ±10 % (1630 - 1650 nm) |
| 峰值灵敏度 | 1550 nm |
| 最小重复率 ⁴ | 155 kHz |

1. 1064 nm, 附有衰减器。查看其他波长的最大功率曲线。
2. 1550 nm, 标称值。实际值取决于环境电磁干扰和波长。
3. 附有衰减器。查看用户手册, 了解不使用衰减器校准的不确定性。
4. 详细信息请参阅用户手册。

损坏阈

| | |
|----------|-----------------------|
| 最大平均功率密度 | 100 W/cm ² |
|----------|-----------------------|

物理特性

| | |
|----------|----------------|
| 孔径 | 5 mm |
| 吸收器 | Ge |
| 尺寸 | 38.1Ø x 36D mm |
| 重量 | 0.14 kg |
| 距传感器表面距离 | 10.5 mm |

订购信息



PH20-Ge-OD1-D0

200874

PH20-Ge-OD1-INT-D0

202796

PH20-Ge-OD1-IDR-D0

203244

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表